

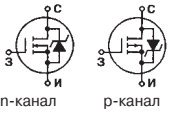

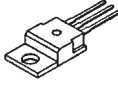
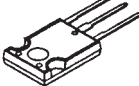

МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

INTERSIL является мировым лидером в производстве **Power MOSFET**.

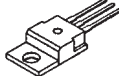
Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов. Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

Power MOSFET, серия IRF

 n-канал p-канал		 TO-204		 TO-220AB		 TO-247		 DIP-4			
Максим. значения											
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$									
n-канал											
100	1,0	0,6							IRFD110		
	1,3	0,3							IRFD120		
	5,6	0,54			IRF510						
	9,2	0,27		IRF120	IRF520						
	14,0	0,16		IRF130	IRF530						
	28,0	0,077			IRF540		IRFP140				
200	40,0	0,055		IRF150			IRFP150				
	0,6	1,5						IRFD210			
	0,80	0,8						IRFD220			
	3,3	1,5			IRF610						
	5,0	0,8		IRF220	IRF620						
	9,0	0,4		IRF230	IRF630						
400	18,0	0,18		IRF240	IRF640		IRFP240				
	33,0	0,085		IRF250			IRFP250				
	2,0	3,6				IRF710					
	3,3	1,8									
	5,5	1,0		IRF330	IRF730						
	10,0	0,55			IRF740						
500	16,0	0,3		IRF350			IRFP350				
	23,0	0,2					IRFP360				
	2,5	3,0			IRF820						
	4,5	1,5			IRF830						
	8,0	0,85		IRF440	IRF840						
	14,0	0,4		IRF450			IRFP450				
100	20,0	0,27					IRFP460				
	p-канал										
	100	1,0	0,6						IRFD9120		
		3,0	1,2			IRF9510					
		6,0	0,6			IRF9520					
		12,0	0,3		IRF9130	IRF9530					
200	19,0	0,2		IRF9140	IRF9540		IRFP9140				
	3,5	1,5			IRF9620						
	6,5	0,8			IRF9630						
	11,0	0,5		IRF9240	IRF9640						

Mega FET серия

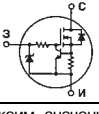
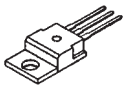
 n-канал p-канал		 TO-220AB	
Максим. значения			
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
n-канал			
50	15	0,1	RFP15N05
	25	0,047	RFP25N05
	50	0,22	RFP50N05
100	22	0,080	RFP22N10
	40	0,040	RFP40N10
p-канал			
50	8	0,300	RFP8P05
	15	0,150	RFP15P05
	30	0,065	RFP30P05
n-канал, управление логическим уровнем			
50	4	0,800	RFP4N05L
	15	0,100	RFP15N05L
	25	0,047	RFP25N05L
	50	0,022	RFP50N05L
100	2	1,050	RFP2N10L
	12	0,200	RFP12N10L
200	2	3,500	RFP2N20L
	8	0,500	RFP8N20L
p-канал, управление логическим уровнем			
30	10	0,225	RFP10P03L



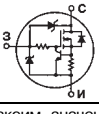
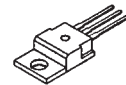
n-канальные MOSFET, серия BUZ

 TO-220AB	Максимальные значения			Максимальные значения			
	$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
50	14,0	0,1		200	9,5	0,4	BUZ32
	30,0	0,04		400	3,0	1,8	BUZ76
	9,0	0,25			5,5	1,0	BUZ60
100	19,0	0,1		500	4,0	2,0	BUZ42
200	5,8	0,6					BUZ73A

Улучшенные Power MOSFET

 Максим. значения		 TO-220AB	
$V_{си, В}$	$I_{си(огр.), А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
80	5,5	0,12	RLP5N08LE

RLP5N08LE
Имеют встроенную схему, ограничивающую max значения $I_{си}$ на уровне 1 А и 5,5 А соответственно. Встроенный стабилизатор защищает от статического электричества до 2 кВ.

 Максим. значения		 TO-220AB	
$V_{си, В}$	$I_{си(огр.), А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
55	1	0,75	RLP1N06CLE

RLP1N06CLE
Имеют схему ограничения $I_{си}$, защелку по напряжению (уровень 60÷70 В), встроенный стабилизатор для защиты от статического электричества до 2 кВ.

